

关键指标

频率：10~13GHz

增益：30dB

噪声系数：0.9dB

1dB 压缩点输出功率：16dBm

电压/电流：+5V/70mA

芯片尺寸：1.8mm×1.1mm

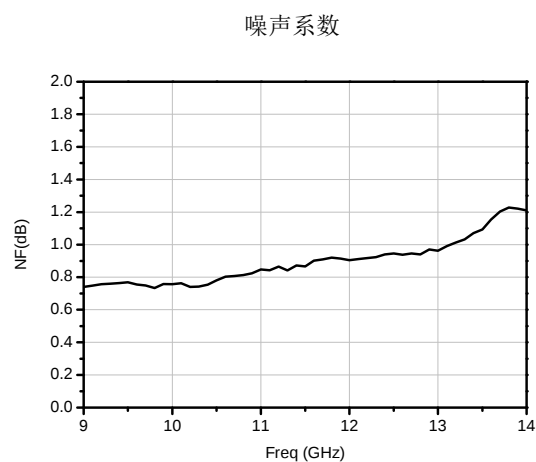
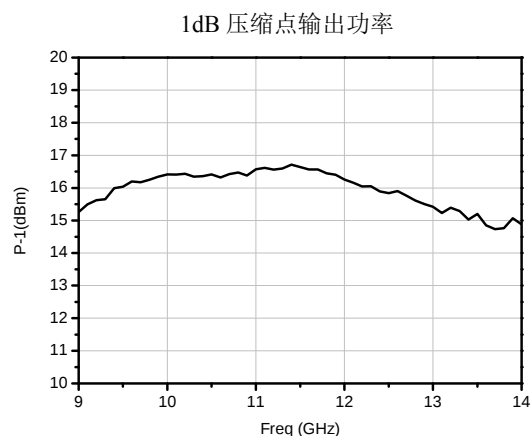
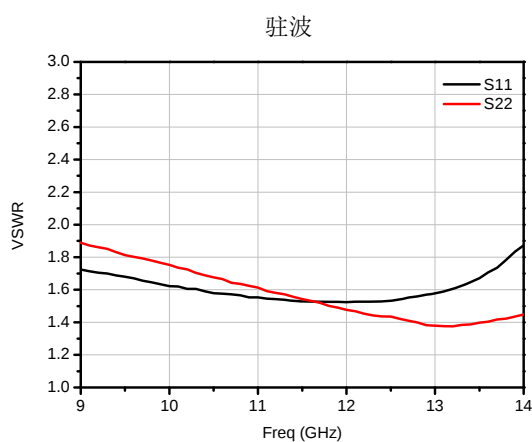
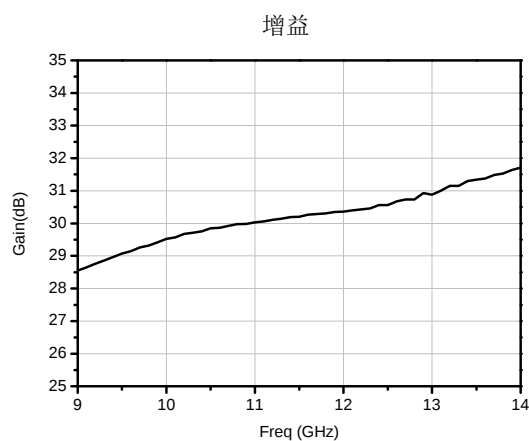
产品简介

HG115FS是一款10~13GHz 低噪声放大器芯片，单电源供电，输入输出端均已集成隔直电容。广泛应用于无线通信。

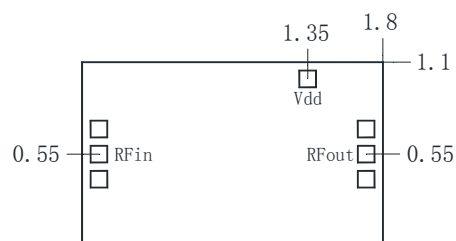
电性能 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=+5\text{V}$)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	10~13		
增益(dB)	-	30	-
增益平坦度(dB)	-	± 0.6	-
输入驻波	-	1.6	-
输出驻波	-	1.6	-
噪声系数(dB)	-	0.9	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	16	-
静态电流 (mA)	-	70	-

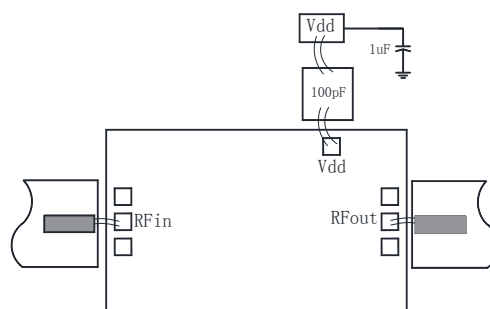
典型测试曲线



外形和端口尺寸(mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。